



表 3(完)

检验或试验	符号	引用标准	条件 除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ (见 GB/T 4589.1 —1989 的第 4 章)	检验要求 极限	
				最小值	最大值
截止电流 <sup>3)</sup>				2USL	
正向电流传输比	$h_{21E(1)}$			0.8LSL	1.2USL <sup>4)</sup>
CRRL 分组	提供 C2、C3、C4、C6、C7 和 C9 的记数检查结果, C8 前后的测试数据				
5) 对于特殊外形,例如微型器件,可以不要求。					

## 9 D 组——鉴定批准试验

[当要求时,本试验应在详细规范中加以规定(只供鉴定批准用).]

## 10 附加资料(不作检验用)

[只要器件规范和使用需要,就应给出附加资料,例如:

- 与极限值有关的温度降额曲线;
- 测试电路或补充方法的完整说明;
- 详细的外形图.]

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6217—1998  
idt IEC 747-7-1:1989  
QC 750102

## 半导体器件 分立器件 第 7 部分:双极型晶体管

## 第一篇 高低频放大环境额定的双极型 晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices  
Part 7:Bipolar transistors  
Section One—Blank detail specification for  
ambient-rated bipolar transistors  
for low and high frequency amplification



版权专有 不得翻印

\*  
书号:155066·1-15868  
定价: 12.00 元

\*  
标目 375—11

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

表 3(续)

检验或试验	符号	引用标准	条 件 除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ (见 GB/T 4589.1 —1989 的第 4 章)	检验要求 极限	
				最小值	最大值
<b>C3 分组<sup>5)</sup></b> 引出端强度: 拉力 和(或) 转矩(D)		GB/T 4937—1995 Ⅱ, 1.1 GB/T 4937—1995 Ⅱ, 1.4	拉力=[规定值] 转矩=[规定值]	无损伤或按规定	
<b>C4 分组</b> 耐焊接热 (D) 最后测试: 截止电流 <sup>3)</sup> 正向电流传导比	$h_{21E(1)}$	GB/T 4937—1995 Ⅱ, 2.2	[按规定] 周期=180 d	LSL	USL USL <sup>4)</sup>
<b>C6 分组</b> 恒定加速度 [仅对空腔器件] 最后测试: 截止电流 <sup>3)</sup> 正向电流传导比	$h_{21E(1)}$	GB/T 4937—1995 Ⅱ, 5	[按规定]	LSL	USL USL <sup>4)</sup>
<b>C7 分组</b> 稳态湿热(D) 或 循环湿热(D) [仅对非空腔器件] 最后测试: 截止电流 <sup>3)</sup> 正向电流传导比	$h_{21E(1)}$	GB/T 4937—1995 Ⅲ, 5 GB/T 4937—1995 Ⅲ, 4	85°C, 相对湿度 85% $V_{CB}=[\text{额定电压的 } 85\% \text{ 直至最大值 } 100 \text{ V}]$ 时间: 168 h [按规定]	0.8LSL	2USL 1.2USL <sup>4)</sup>
<b>C8 分组</b> 电耐久性 (1 000 h) 最后测试: 截止电流 <sup>3)</sup> 正向电流传导比 噪声系数(dB) [仅对低噪声器件]	$h_{21E(1)}$ F	GB/T 4587—1994 V	高温反偏或工作寿命[在高温下] (耗散功率 = $P_{totmax}$ 的 80% 至 100%) [按规定]	0.8LSL	2USL 1.2USL <sup>4)</sup> 1.5USL
<b>C9 分组</b> 高温贮存(D) 最后测试:		GB/T 4937—1995 Ⅲ, 2	在 $T_{stgmax}$ 下, 至少 1 000 h		

中华人民共和国  
国家标准  
半导体器件 分立器件  
第 7 部分: 双极型晶体管  
第一篇 高低频放大环境额定的双极型  
晶体管空白详细规范  
GB/T 6217—1998  
\*  
中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045  
电 话: 68522112  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印  
\*  
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 26 千字  
1999 年 6 月第一版 1999 年 6 月第一次印刷  
印数 1—1 000

\*  
书号: 155066·1-15868 定价 12.00 元

表 3(续)

检验或试验	符号	引用标准	条件 除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ (见 GB/T 4589.1 —1989 的第 4 章)	检验要求 极限			
				LF		HF	
				最小值	最大值	最小值	最大值
共基极输出电容	$C_{22b}$	N, 1.8.1	$V_{CB} = [\text{规定值 (最好 } 10 \text{ V)}], I_E = 0, f = 1 \text{ MHz}$		×		×
适用时: 共发射极反向传输电容	$C_{12e}$	N, 1.8.2	$V_{CB} = [\text{规定值}], I_B = 0$ $f = [\text{规定值 (最好 } 1 \text{ MHz)}]$			×	
适用时: 反向传输时间常数	$\tau_{re}$	[按规定]	$V_{CB} = [\text{规定值}]$ $I_B = [\text{规定值}]$ $f = [\text{规定值}]$			×	
<b>C2b 分组</b>							
同一管壳或封装内有配对晶体管: 在 $T_1 = 25^{\circ}\text{C}$ 与规定高温 $T_2$ 之间基极-发射极电压之差的变化	$ \Delta(V_{BE1} - V_{BE2}) _{\Delta T}$	GB/T 4587—1994 N, 2, 6	$V_{CE} = [\text{规定值}]$ $I_C = [\text{规定值}]$ (最好在典型工作电压和电流下)  [直流或脉冲, 按规定 <sup>1)</sup> ]以及		×		
适用时: 共发射极正向电流传输比的静态值:							
——大信号器件	$h_{21E(2)}$	GB/T 4587—1994 N, 2, 7	$V_{CE} = [\text{规定低的电压}]$ $I_C = [\text{规定大的电流}]$	×		×	
——小信号器件	$h_{21E(3)}$		$V_{CE} = [\text{规定值}]$ $I_C = [\text{规定小的电流}]$	×		×	
高温下的截止电流 取下列其中一个或一个以上:			$T_{amb} = [\text{规定的高温}]$				
集电极-基极截止电流	$I_{CBO(2)}$	N, 1.2.1	$V_{CB} = [\text{最好在 } V_{CB0max} \text{ 的 } 65\% \text{ 与 } 85\% \text{ 之间}]$ $I_E = 0$	×		×	
集电极-发射极截止电流	$I_{CEX(2)}$	N, 1.3	$V_{CE} = [\text{最好在 } V_{CEXmax} \text{ 的 } 65\% \text{ 与 } 85\% \text{ 之间}]$ $V_{BE} = [\text{规定的 X}]$	×		×	
集电极-发射极截止电流	$I_{CER(2)}$	N, 1.3	$V_{CE} = [\text{最好在 } V_{CERmax} \text{ 的 } 65\% \text{ 与 } 85\% \text{ 之间}]$ $R_{BE} = [\text{规定的 R}]$	×		×	
集电极-发射极截止电流	$I_{CES(2)}$	N, 1.3	$V_{CE} = [\text{最好在 } V_{CESmax} \text{ 的 } 65\% \text{ 与 } 85\% \text{ 之间}]$ $V_{BE} = 0$	×		×	
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO(2)}$	N, 1.3	$V_{CE} = [\text{最好在 } V_{CEOmax} \text{ 的 } 65\% \text{ 与 } 85\% \text{ 之间}]$ $I_B = 0$	×		×	

## 前 言

本规范是等同采用国际标准 IEC 747-7-1:1989《半导体器件 分立器件 高低频放大环境额定的双极型晶体管空白详细规范》第一版对 GB/T 6217—1986 进行修订的。

本规范与前版的主要差别是增加了配对晶体管的技术要求。

本规范由中华人民共和国电子工业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范由电子工业部标准化研究所负责起草。

本规范主要起草人:王长福、顾振球、邓康、黄世杰。